

IEEE EDS Kansai Chapterの皆様
IEEE Kansai Section の皆様

2020年11月13日
IEEE EDS Kansai Chapter Chair 吉本 昌広
Vice Chair 渡辺 博文

下記の通り、第20回「関西コロキウム電子デバイスワークショップ」と「IMFEDK2020 Satellite event」を開催致します。今年度はIEEE EDS Kansai Chapter主催の国際会議IMFEDK2020がコロナウイルスの影響のため延期となりました。その為今年度は若手研究者への発表の機会を設けるために、若手研究者のためのIMFEDK2020 Satellite eventを関西コロキウム電子デバイスワークショップと同時開催することになりました。
会員の皆様のご参加をお待ち申し上げます。

記

会議名：第20回「関西コロキウム電子デバイスワークショップ」
「IMFEDK2020 Satellite event」

主催：IEEE Electron Devices Society Kansai Chapter

日時：2020年11月27日（金）9:00～16:50

会場：オンライン

場所：オンライン（京都工芸繊維大学）

プログラム：次ページ以降参照

公用語：日本語（関西コロキウム電子デバイスワークショップ）

英語（IMFEDK2020 Satellite event）

会費：無料（事前登録必要、Zoom招待のため）

参加希望の方は、下記の問い合わせ先まで連絡ください。後日参加方法について連絡いたします。
また、人数は100人までと制限させていただきます。先着順での登録になりますので、制限になってしまった場合には登録を締め切らせていただく場合がありますので、ご了承ください。

【お問い合わせ先】

IEEE EDS Kansai Chapter Secretary: 西中 浩之（京都工芸繊維大学; nisinaka@kit.ac.jp）

=====

<ご講演頂く皆様へ（関西コロキウム電子デバイスワークショップ）>

講演時間：20分 + 質疑：5分（全て日本語）

使用器具：Zoomを使用した経験がない場合は事前に西中（nisinaka@kit.ac.jp）までご連絡ください。接続テストを実施させていただきます。当日、特別な資料をご用意いただく必要はありません。

2020年11月27日（金）

オンライン

開会挨拶 [9:00 - 9:05]

吉本 昌広（京都工芸繊維大学）

IMFEDK Short Presentation [9:05 - 10:05]

西中 浩之（京都工芸繊維大学）

Session I. Power and Compound Semiconductor Devices [10:10-11:25]

座長：アスバル ジョエル タクラ（福井大学）

Impact Ionization Coefficients in GaN Measured by Above- and Sub-Eg Illuminations for p-/n+ Junction[IEDM]

Takuya Maeda, Tetsuo Narita, Shinji Yamada, Tetsu Kachi, Tsunenobu Kimoto, Masahiro Horita, and Jun Suda
Kyoto University

Improvement in the Channel Performance and NBTI of SiC-MOSFETs by Oxygen Doping[IEDM]

M. Noguchi, T. Iwamatsu, H. Amishiro, H. Watanabe, K. Kita and N. Miura
Mitsubishi Electric Corporation

Demonstration of Conductivity Modulation in SiC Bipolar Junction Transistors With Reduced Base Spreading Resistance[IEEE TED]

Satoshi Asada, Jun Suda, and Tsunenobu Kimoto
Kyoto University

— 休憩 [11:25-12:30] —

IMFEDK Poster Presentation [12:30 - 14:00]

西中 浩之（京都工芸繊維大学）

Session II. CMOS Process, Device, and Circuit [14:05-14:55]

座長：廣木 彰（京都工芸繊維大学）

Reliability Issues in Analog ReRAM Based Neural-Network Processor [IEEE IRPS]

R. Yasuhara, T. Ono, R. Mochida, S. Muraoka, K. Kouno, K. Katayama, Y. Hayata, M. Nakayama, H. Suwa, Y. Hayakawa, T. Mikawa, Y. Gohou, and S. Yoneda
Nuvoton Technology Corporation Japan

Effects of Variability in Plasma-Induced Damage to Si Substrate on Device Performance and Its Application to Variability Assessment Methodology [SSDM]

T. Hamano, K. Urabe, K. Eriguchi
Kyoto University

— 休憩 [14:55-15:10] —

Session III. Sensor, Solar Cell, and Emerging Devices [15:10-16:25]

座長：浦岡 行治（奈良先端科学技術大学院大学）

Bottom-Contact Pentacene Thin-Film Transistor with Threshold Voltages Controlled by Oxygen Plasma Treatment [SSDM]

H. Fujita, Y. Kimura, Y. Hattori and M. Kitamura
Kobe University

Experimental study of bias stress degradation of organic thin film transistors [SSDM]

K. Oshima, M. Saito, M. Shintani, K. Kuribara, Y. Ogasahara, and T. Sato
Kyoto University

Effect of Device Structure on the Narrow-band Light Detection of Bulk Heterostructure Organic Photodetectors based on Poly(3-hexylthiophene) and Fullerene Derivative [AMFPD]

H. Okui, H. Kajii and M. Kondow
Osaka University

AWARD授与 [16:25-16:40]

上田 尚宏 (リコー電子デバイス)

閉会挨拶 [16:40-16:50]

吉本 昌広 (京都工芸繊維大学)